

Содержание

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Морозова Н.К., Канахин А.А., Шнитников А.С.

Растворимость кислорода в монокристаллах CdS и их физико-химические свойства 865

Середин П.В., Федюкин А.В., Арсентьев И.Н., Вавилова Л.С., Тарасов И.С., Prutskij Tatiana, Leiste Harald, Rinke Monika

Структурные и оптические свойства GaAs(100) с тонким приповерхностным слоем, легированным хромом 869

● Электронные свойства полупроводников

Ромака В.А., Rogl P., Ромака В.В., Kaczorowski D., Стадник Ю.В., Крайовский В.Я., Горынь А.М.

Особенности механизмов проводимости сильно легированного и компенсированного полупроводника $V_{1-x}Ti_xFeSb$. 877

Кудряшов А.А., Кытин В.Г., Лукин Р.А., Кульбачинский В.А., Banerjee A.

Влияние легирования таллием на подвижности электронов в Bi_2Se_3 и дырок в Sb_2Te_3 886

Марченко А.В., Теруков Е.И., Серегин П.П., Раснюк А.Н., Киселев В.С.

Электронный обмен между примесными U^- -центрами олова в твердых растворах PbS_xSe_{1-x} 893

Иванов П.А., Потапов А.С., Самсонова Т.П., Грехов И.В.

Полосная зависимость дрейфовой скорости электронов в 4H-SiC вдоль оси c 900

● Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Богословский Н.А., Петров П.В., Иванов Ю.Л., Аверкиев Н.С., Цэндин К.Д.

Влияние кулоновских корреляций на люминесценцию и поглощение в компенсированных полупроводниках 905

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Жуков Н.Д., Глуховской Е.Г., Мосияш Д.С.

Локальная эмиссионная спектроскопия микрозерен поверхности полупроводников $A^{III}B^V$ 911

Кожухов А.С., Щеглов Д.В., Латышев А.В.

Индисные нанопроволоки на поверхности кремния 918

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Кузнецова Я.В., Жмерик В.Н., Нечаев Д.В., Кузнецов А.М., Заморянская М.В.

Особенности катодолюминесцентных спектров квантовых ям AlInGaIn, вызванные влиянием фазового распада и внутренних электрических полей 921

Романов В.В., Дементьев П.А., Моисеев К.Д.

Влияние поверхности многокомпонентной матрицы InAsSbP на формирование квантовых точек InSb при наращивании методом МОГФЭ 927

Васильев Ю.Б., Михайлов Н.Н., Васильева Г.Ю., Иванов Ю.Л., Захарьин А.О., Андрианов А.В., Воробьев Л.Е., Фирсов Д.А., Григорьев М.Н., Антонов А.В., Иконников А.В., Гавриленко В.И.

Терагерцовое излучение из квантовых ям CdHgTe/HgTe с инвертированной структурой зон 932

Иванов П.А., Кудояров М.Ф., Козловский М.А., Потапов А.С., Самсонова Т.П.

Полуизолирующие слои 4H-SiC, полученные имплантацией высокоэнергетических (53 МэВ) ионов аргона в эпитаксиальные пленки n -типа проводимости 937

Соболев М.М., Солдатенков Ф.Ю., Козлов В.А.

Исследования глубоких уровней GaAs $p-i-n$ -структур . 941

Именков А.Н., Гребенщикова Е.А., Шутаев В.А., Оспенников А.М., Шерстнёв В.В., Яковлев Ю.П.

Фотоэде и фототок в структурах Pd-оксид-InP в атмосфере водорода 946

Кривякин Г.К., Володин В.А., Кочубей С.А., Камаев Г.Н., Purkrt A., Remes Z., Fajgar R., Stuchliková T.H., Stuchlik J.

Оптические свойства $p-i-n$ -структур на основе аморфного гидрогенизированного кремния с нанокристаллами кремния, сформированными с применением наносекундных лазерных отжигов 952

● Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Фефелов С.А., Казакова Л.П., Арсова Д., Козюхин С.А., Цэндин К.Д., Приходько О.Ю.

Осцилляции напряжения при эффекте переключения в режиме токовой моды в тонких слоях халькогенидов системы Ge-Sb-Te 958

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Селюков А.С., Исаев А.А., Витухновский А.Г., Литвак В.Л., Кацаба А.В., Коршунов В.М., Васильев Р.Б.

Нелинейно-оптический отклик нанокристаллов CdSe планарной и сферической геометрии 963

● **Углеродные системы**

Котоусова И.С., Лебедев С.П., Лебедев А.А.

Электроннографическое исследование стадий формирования графеновой пленки при термодеструкции $6H\text{-SiC}$ (0001) в вакууме 967

● **Физика полупроводниковых приборов**

Кюрегян А.С., Горбатюк А.В., Иванов Б.В.

Влияние инжекционной способности анодного эмиттера на характеристики комбинированных СИТ–МОП транзисторов 973

Астрова Е.В., Румянцев А.М., Ли Г.В., Нащекин А.В., Казанцев Д.Ю., Бер Б.Я., Жданов В.В.

Электрохимическое литирование кремния с разной кристаллографической ориентацией 979

Минтаиров М.А., Евстропов В.В., Минтаиров С.А., Тимошина Н.Х., Шварц М.З., Калюжный Н.А.

Растекание тока в солнечных элементах: двухпараметрическая трубковая модель 987

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Пархоменко Я.А., Дементьев П.А., Моисеев К.Д.

Квантовые точки в системе InSb/GaSb , выращенные методом жидкофазной эпитаксии 993

Николаев В.И., Печников А.И., Степанов С.И., Шарофидинов Ш.Ш., Головатенко А.А., Никитина И.П., Смирнов А.Н., Бугров В.Е., Романов А.Е., Брунков П.Н., Кириленко Д.А.

Хлоридная эпитаксия слоев $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ на сапфировых подложках базисной ориентации 997

Марков Л.К., Смирнова И.П., Павлюченко А.С., Кукушкин М.В., Закгейм Д.А., Павлов С.И.

Способ получения пленок ИТО с контролируемым значением показателя преломления 1001